

بهینه سازی خواص تشعشعی بهینه نانو مقیاس در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش با الگوریتم ازدحام ذرات

سید امیر عباس علومی^۱، مهدی محمدی^{۲*}

^۱ گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

^۲ گروه مهندسی برق، واحد تفت، دانشگاه علمی و کاربردی، یزد، ایران

دریافت: زمستان ۹۶ پذیرش: زمستان ۹۶

چکیده

لایه نازک به لایه‌ای از مواد گویند که دارای ضخامت نانومتری تا محدوده چندین میکرومتر می‌باشد. این لایه بر روی سطح قطعات و مواد دیگر قرار گرفته و به آنها خصوصیت ویژه و جدیدی را می‌بخشد. خواص لایه‌های نازک، نظیر خواص مکانیکی، نوری، الکتریکی و غیره به پارامترهای زیادی وابسته است که این پارامترها مربوط به روش تولید، کیفیت و نوع ماده‌ی زیرلایه خواهد بود. با توجه به عملکرد و خواص لایه‌های نازک، می‌توان از آنها جهت بهبود تکنولوژی‌های نظیر سلول‌های خورشیدی، سنسورها، کاربردهای نوری، مهندسی الکترونیک و فروالکترونیک نیز استفاده نمود و امروزه کاربرد لایه‌نشانی در صنایع، موضوع توسعه یافته‌ای است، به گونه‌ای که بخش بزرگی از زندگی مدرن را مدیون توسعه صنعت لایه‌نشانی می‌دانند. در پژوهش پیش‌رو خواص تشعشعی طیفی، جهتی و وابسته به دما از قبیل ضربی بابت، ضربی عبور و ضربی گسیل برای نانو پوشش‌ها شامل سیلیکون، دی‌اکسید سیلیسیم، نیترات سیلیسیم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به دنبال جواب بهینه برای این ضرایب در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش می‌باشد، بدین صورت که این الگوریتم با انتخاب مناسب‌ترین ترکیب از جنس، تعداد و ضخامت لایه، بهترین خواص تشعشعی را در طیف کامل نوری نتیجه خواهد داد.

*مددگار مکاتبات: mm6400y@gmail.com

کلمات کلیدی: لایه‌های نازک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، خواص تشعشعی، بهینه سازی

لایه نازک، امروزه کاربردهای گسترده‌ای یافته است، از کاربردهای الکترونیکی، انرژی‌های نو و پوشش‌های سخت، مقاوم در برابر خوردگی و سایش گرفته تا کابردهای دکوراسیون و نمای ساختمان‌ها کاربرد دارد [۲].

لایه‌ها با دقت اتمی طراحی شده ای از انواع مواد اعم از فلزات، عایق‌ها، نیمه رساناها هستند. که آنها را می‌توان در دسته پوشش‌های نانو ساختار دسته‌بندی کرد. همچنین کاربرد عمده این لایه‌های نازک در اصلاح خواص سطح جامدات است [۴].

لایه‌های نازک و بسیار نازک، از دو ویژگی مهم برخوردار هستند. اولین ویژگی، ضخامت زیرمیکرونی آنها است که هر چه به اندازه نانو نزدیکتر شوند، ویژگی‌های متفاوت‌تری را برای لایه به وجود می‌آورند. دومین ویژگی، لایه‌ها می‌توانند سطوح فوق العاده بزرگی نسبت به ضخامت داشته باشند. این دو ویژگی باعث پدید آمدن خواص متفاوت و کاربردی بیشتری می‌شوند [۳ و ۴].

خواص لایه‌های نازک، نظیر خواص مکانیکی، نوری، الکتریکی و غیره به پارامترهای زیادی وابسته است که این پارامترها مربوط به روش تولید، کیفیت و نوع ماده‌ی زیرلایه خواهد بود. در مورد روش‌های لایه نشانی از پارامترهای مربوط به روش تولید می‌توان به میزان خلا، جریان گاز

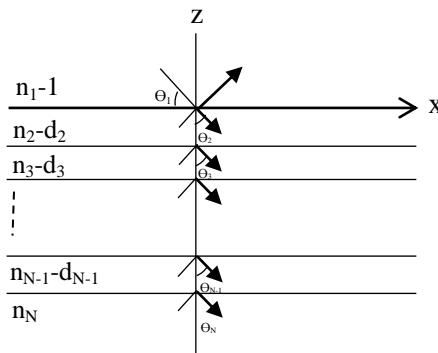
۱- مقدمه

در حدود چهار هزار سال پیش، هنر چکش کاری طلا با تولید ورقه‌های بسیار نازک زیبا و پایدار در برابر فرایندهای شیمیایی کاربرد داشته است. همچنین در گذشته، سالیان متمادی، لایه نشانی جیوه بر روی قطعات مسی انجام می‌گرفته است. در سال‌های اخیر، علم لایه‌های نازک در میان سایر علوم، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بی‌شك رشد چشمگیر ارتباطات، پردازش اطلاعات، ذخیره سازی، صفحه‌های نمایش، صنایع ترئینی، ابزارآلات نوری، مواد سخت و عایق‌ها نتیجه تولید لایه‌های نازک براساس فناوری‌های نوین می‌باشد [۱].

لایه نازک به لایه‌ای از مواد گویند که دارای ضخامت نانومتری تا محدوده چندین میکرومتر می‌باشد. این لایه بر روی سطح قطعات و مواد دیگر قرار گرفته و به آنها خصوصیت ویژه و جدیدی را می‌بخشد [۲].

به طور کلی لایه به ماده یا ماده گفته می‌شود که به صورت پوششی بر یک سطح یا ماده می‌نشینند و باعث ایجاد خواص الکتریکی، فیزیکی و مکانیکی سطحی جدیدی می‌شود که خصوصیات سطحی زیرلایه را ارتقاء می‌بخشد [۳].

۱-۲- فرمولاسیون لایه‌های نازک در محاسبات، خواص نوری هوا را با خواص خلا پکسان در



شکل ۱: هندسه یک ساختار چند لایه‌ای

نظر می‌گیریم. موج الکترومغناطیس از اولین محیط مادی (هوای) با زاویه به ساختار چندلایه‌ای برخورد می‌کند و توسط لایه‌های زیرین بازتاب یا عبور می‌کند.

بردار موج به کمک رابطه (۱) نشان داده می‌شود.

$$q_j = q_{jx} \hat{x} + q_{jz} \hat{z} \quad (1)$$

q_{jx} و q_{jz} اجزای موازی و عمودی بردار موج هستند.

جزء موازی بردار موج q_{jx} از رابطه زیر به دست می‌آید: [۹]

$$q_x = q_{jx} = \frac{2\pi}{\lambda} n_1 \sin \theta_1 \quad (2)$$

هرگاه بردار میدان الکتریکی عمود به صفحه اشعه ورودی باشد، اشعه ورودی قطبی از نوع S¹ می‌باشد و هرگاه بردار میدان الکتریکی موازی صفحه اشعه ورودی باشد، اشعه ورودی قطبی از نوع P² گویند. از اینرو با اعمال شرایط مرزی در هر یک از سطوح مشترک بین لایه‌ها، می‌توان ضرایب A₁ و B₁ را به ضرایب A_N و B_N به کمک معادله مرتبط ساخت. [۳]

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A_N \\ B_N \end{pmatrix} \quad (3)$$

و ماتریس M از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$M = \prod_{j=1}^{N-1} P_j D_j^{-1} D_{j+1} \quad (4)$$

یک عدد حقیقی است و $B_N = 0$ می‌باشد. در نتیجه خواص تشعشعی طیفی جهتی یک ساختار چندلایه‌ای شامل ضریب بازتاب $\rho_{\lambda, \theta}$ و ضریب عبور $\tau_{\lambda, \theta}$ با توجه به مفهوم و تعریف هر کدام از خواص تشعشعی از روابط زیر محاسبه می‌گردد: [۹]

عبوری حین فرایند رشد لایه، سرعت لایه نشانی و خلوص مواد پوشش اشاره کرد [۳].

با توجه به عملکرد و خواص لایه‌های نازک، می‌توان از آنها جهت بهبود تکنولوژی‌هایی نظری سولول‌های خورشیدی، سنسورها، کاربردهای نوری، مهندسی الکترونیک و فروالکترونیک نیز استفاده نمود و امروزه کاربرد لایه نشانی در صنایع، موضوع توسعه یافته‌ای است، به گونه‌ای که بخش بزرگی از زندگی مدرن را مدینون توسعه صنعت لایه نشانی می‌دانند.

در زمینه لایه‌های نازک فخاران و همکاران در سال ۱۳۹۵ در یافتند با افزایش مقدار اکسیدانت، افزایش دما و افزایش زمان سایز صفات اکسید گرافن کاهش می‌یابد. این امر باعث افزایش مقاومت اتصال بین صفات و کاهش هدایت الکتریکی از $4/56 \times 10^{-4}$ به $1/23 \times 10^{-4}$ می‌گردد. لایه نازک‌های اکسید گرافن کاهش یافته، بعد از قرارگیری در معرض بخار حاصل شدند. پارامترهایی چون ضخامت لایه‌ها و دمای پخت بر شفافیت و مقاومت سطحی لایه‌ها بررسی شد [۵].

چودی و همکاران در سال ۲۰۱۴ شبیه ساز حرارتی شناخته شده هاتاپوت را برای اصلاح معادلات تی ای مورد استفاده قرار دادند و در شبیه‌ساز توانستند به کاهش دمایی ۱۱ درجه برسند و یا توان کارکرد چیپست را ۸۵ میلیوات افزایش دهند. این بدان معنیست که می‌توانند تراشه‌های ۱۲۰۰ مگاهرتز را به روش تی ای به ۱۶۰۰ مگاهرتز رساند [۶]. سیلیک و همکاران در سال ۲۰۱۷ ورقه‌های نازک دی اکسید تیتانیوم را بر روی فلورین اکسیدقلع و زیرلایه‌های اکسیدقلع و منیزیم بوسیله کوره قوس حرارتی خلاء پوشانده و ضریب انتشار، کارایی رنگ، مدولاسیون نوری و برگشت پذیری را محاسبه کردند. بهترین نتایج برای نمونه دی اکسید تیتانیوم بر روی فلورین اکسیدقلع با کارایی رنگی cm^2 ۱۸.۶ بدست آمد [۷].

یانگ با همکاران در سال ۲۰۱۷ کنترل فاز برای به دست آوردن سولول‌های خورشیدی با کارایی بالا مورد تحقیق قرار دادند. وقتی که تلوریدمس به عنوان یک تماس پشتی برای سولول‌های خورشیدی تلوریدمس استفاده شود. لایه بافر تماسی کریستال تکفاری سیستم تلورایدمس به راحتی مشخصات دیدو را بهبود می‌دهد و عملکرد وسیله را بالا می‌برد. تکفار تلورایدمس اساساً توسط نسبت تلوراید و مس، از طریق روش تبخیر باهم در ترکیب با واکنش گرمایی سریع کنترل می‌شود [۸].

۲- معادلات حاکم

لایه‌های بلوری، از ضخامت نانومتر تا چندین میکرومتر، به وسیله رسوب بخار بر روی بسترها نیمه رسان، تولید می‌شوند. این ساختارهای لایه‌ای نقش مهمی در تکنولوژی‌های اخیر، از جمله مدارهای مجتمع، لیزرهای نیمه رسان، آشکارکننده‌های چاه کوانتومی، قطعات هیبریدی نیمه رسان / ابررسان، فیلترهای نوری، و پوشش‌های انتخابی طیفی برای عملکردهای حرارتی خورشیدی ایفا می‌کنند.

خواص تشعشعی بازتاب، عبور و جذب ساختارهای چند لایه‌ای علاوه بر واستگی به دما به جهت و طول موج اشعه ورودی نیز وابسته هستند. همچنین این خواص، تحت تاثیر پوشش‌های نازک نیز می‌باشند.

به سمت نواحی موفق میل می‌کنند و ذرات از یکدیگر می‌آموزند و بر مبنای دانش بدست آمده به سمت بهترین همسایگان خود می‌روند.^[۱۲] اساس کار PSO بر این اصل استوار است که در هر لحظه هر ذره مکان خود را در فضای جستجو با توجه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرار گرفته است و بهترین مکانی که در کل همسایگی‌اش وجود دارد، تنظیم می‌کند.^[۱۱-۱۳]

ذره در الگوریتم معادل یک پرنده در الگوی حرکت جمعی پرنده‌گان می‌باشد. هر ذره یک مقدار شایستگی دارد که توسط یکتابع شایستگی آن محاسبه می‌شود. هر چه ذره در فضای جستجو به هدف نزدیکتر باشد، شایستگی بیشتری دارد و همچنین هر ذره دارای یک سرعت است که هدایت حرکت ذره را بر عهده دارد. هر ذره با دنبال کردن ذرات بهینه در حالت فعلی، به حرکت خود در فضای مساله ادامه می‌دهد. به این شکل است که گروه‌ای از ذرات PSO آغاز کار، به صورت تصادفی به وجود می‌آیند و با به روز کردن نسلها سعی در یافتن راه حل بهینه می‌نمایند. در هر گام، هر ذره توسط دو تا از بهترین مقدار به روز می‌شود، بهترین موقعیتی که تاکنون ذره، موفق به رسیدن به آن شده است و دیگری، بهترین موقعیتی که در بین ذرات بدست آمده است.^[۱۴] پس از یافتن بهترین مقادیر، سرعت و مکان هر ذره با استفاده از معادلات (۸) و (۹) به روز می‌شود.^[۱۱-۱۵]

سرعت ذرات تنها با توجه به موقعیت فعلی و بهترین تجربه ذره و بهترین تجربه جمع تعیین می‌شود. به این ترتیب، بهترین ذره جمع، در جای خود ثابت می‌ماند و سایرین به سمت آن ذره حرکت می‌کنند.^[۱۶] برای اتمام الگوریتم روش‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان تعداد تکرار را شرط اتمام الگوریتم و یا اگر تعداد مشخصی از جواب بهینه الگوریتم ثابت و بدون تغییر باشد موجب اتمام کار و مشخص کردن ذره بهینه بشود.^[۱۶-۱۷]

۳-نتیجه گیری

در این تحقیق، خواص تشعشعی طیفی، جهتی و وابسته به دما از قبیل ضریب بازتاب، ضریب عبور و ضریب گسیل برای نانو پوشش‌ها شامل سیلیکون، دی‌اکسید سیلیسیم، سیلیکون نیترات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عوامل موثر بر خواص تشعشعی به دقت تجزیه و تحلیل شده، اهمیت و محدوده اهمیت هر کدام نیز مشخص گردید، به بیان دیگر مشاهده خواهد شد که تغییر در جنس، تعداد و ضخامت لایه‌ها باعث تغییراتی در ضرایب بازتاب، عبور و گسیل می‌شود.

این تحقیق با استفاده از الگوریتم توده ذرات در طول موج‌هایی در محدوده نوری مرئی، فرابخش و فروسرخ، جواب‌های بهینه‌ای برای این ضرایب مشخص گردید، بین صورت که این الگوریتم با ایجاد یک جمعیت اولیه برای تعداد لایه‌ها که محدوده لایه‌ها بین ۳ لایه حداقل و ۹ لایه حداکثر قرار دارد و نوع لایه‌ها که می‌تواند سلیسیوم و نیترات‌سیلیکون و دی‌اکسید‌سیلیکون انتخاب می‌شود.

براساس تعداد لایه‌های انتخابی، مقداری بین صفر تا ۲۰۰ نانومتر برای نیترات‌سیلیکون و دی‌اکسید‌سیلیکون و سیلیسیم، ۵۰۰ نانو متر را برای ضخامت لایه‌ها انتخاب می‌کنند. با قرار دادن در تابع هدف مقدار ضرایب عبور و بازتاب و گسیل را بدست می‌آورند. این مقادیر بدست آمد با

$$\rho_{\lambda,\theta} = \frac{B_1 B_1^*}{A_1^2} \quad (5)$$

$$\tau_{\lambda,\theta} = \frac{\operatorname{Re}(\tilde{n}_N \cos \tilde{\theta}_N)}{n_1 \cos \theta_1} \frac{A_N A_N^*}{A_1^2} \quad (6)$$

در معادلات بالا، علامت * مشخص کننده مزدوج مختلط می‌باشد. ضریب جذب طیفی جهتی، از تفاضل ضرایب بازتاب و عبور از عدد یک محاسبه می‌گردد و ضریب گسیل طیفی جهتی $\epsilon_{\lambda,\theta}$ ^۴ به کمک قانون کرشوف^۳ از معادله (۷) محاسبه می‌شود:^[۱۰]

$$\epsilon_{\lambda,\theta} = 1 - \rho_{\lambda,\theta} - \tau_{\lambda,\theta} \quad (7)$$

در تحقیق پیش رو خواص تشعشعی طیفی، جهتی و وابسته به دما از قبیل ضریب بازتاب ρ ، ضریب عبور τ و ضریب گسیل ϵ برای نانو پوشش‌ها شامل سیلیکون، دی‌اکسید سیلیسیم، نیترات سیلیسیم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. عوامل موثر بر خواص تشعشعی به دقت

$$v[t+1] = v[t] + c_1 * \operatorname{rand}() * (pbest[t] - position[t]) + c_2 * \operatorname{rand}() * (gbest[t] - position[t]) \quad (8)$$

$$position[t+1] = position[t] + v[t+1] \quad (9)$$

تجزیه و تحلیل شده، اهمیت و محدوده اهمیت هر کدام نیز مشخص خواهد شد؛ به بیان دیگر مشاهده خواهد شد که تغییر در جنس، تعداد و ضخامت لایه‌ها باعث تغییراتی در ضرایب بازتاب، عبور τ و گسیل ϵ می‌شود. و با استفاده از الگوریتم PSO^۵ به دنبال جواب بهینه برای این ضرایب در محدوده نوری مرئی و فروسرخ و فرابخش می‌باشد؛ بدین صورت که این الگوریتم با انتخاب مناسب‌ترین ترکیب از جنس، تعداد و ضخامت لایه، بهترین خواص تشعشعی را در طیف کامل نوری نتیجه خواهد داد. در ادامه خواص تشعشعی هر ساختار و نحوه تأثیر پارامترهای موثر بر آن‌ها نیز بررسی خواهد شد.

۲-الگوریتم ازدحام ذرات

کلمه PSO به معنی بهینه‌سازی توده ذرات است. توده ذرات در طبیعت برای ما بیانگر هوش جمعی است. حرکت جمعی ماهی‌ها درون آب یا پرنده‌گان هنگام مهاجرت، همگی اعضا با یکدیگر به صورت کاملاً همراهی حرکت می‌کنند.^[۱۱]

PSO یک الگوریتم جستجوی اجتماعی است که از روی رفتار اجتماعی دسته‌های پرنده‌گان مدل شده است. در ابتدا این الگوریتم به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرنده‌گان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه‌ی دسته به کار گرفته شد. در PSO، ذرات در فضای جستجو جاری می‌شوند و تغییر مکان ذرات در فضای جستجو تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان است. بنابراین موقعیت دیگر توده ذرات روی چگونگی جستجوی یک ذره اثر می‌گذارد. نتیجه‌ی مدل‌سازی این رفتار اجتماعی فرایند جستجویی است که ذرات

³ Kirchhoff's Law

⁴ Particle Swarm Optimization

جدول ۳: ضخامت لایه ها در طول موج های مختلف برای ضریب بهینه عبور

جمعیت اولیه برای الگوریتم بهترین جواب محلی و کلی می باشد که آنها را ذخیره می کند. برای بارهای بعدی اجرا الگوریتم توسط معادله (۸) سرعت را برای هر جمعیت اولیه مشخص شده و با معادله (۹) موقعیت بعدی آنها معین می شود و موقعیت جدید با تابع هدف ارزش یابی شده و این به الگوریتم وارد می شود در صورت بهینه تر بودن ذخیره شده و این عملکرد تکرار می شود تا جایی که ذرات در یک موقعیت متراکم شوند و حرکت آنها ناچیز و موقعیت آنها برای تعداد متواالی ثابت بمانند بنابراین این موقعیت جواب بهینه الگوریتم می باشد. با اجرا الگوریتم مناسب ترین ترکیب از جنس، تعداد و ضخامت لایه، بهترین خواص تشعشعی در طول موج های مرئی و فرابیتش و فروسرخ را نتیجه داده شد. که جدول های زیر خروجی های الگوریتم می باشد که در طول موجهای متفاوت جواب بهینه مشخص شده است.

در جدول‌ها تعداد و نوع لایه‌ها در طول موج‌های محدود مرئی، فراینش و فروسرخ مشخص شده است که عدد ۱ معادل ماده سیلیکون، عدد ۲ معادل ماده دی‌اکسید سیلیکون، عدد ۳ معادل نیترات سیلیکون و عدد صفر معادل هوا می‌باشد.

در جدول‌های ضخامت لایه، عدد صفر معادل حذف لایه می‌باشد.
ضخامت لایه‌ها بر حسب میکرومتر می‌باشد.

جدول ۱: شماره اختصاص گرفته در الگوریتم برای هر نوع لایه

نوع لایه	شماره مختص لایه
هوا	.
سیلیکون	۱
دی اکسید سیلیکون	۲
نیتات سلیکون	۳

جدول ۲: نوع و تعداد لایه ها در طول موج های مختلف برای ضریب عبور

نوع لایه ها	طول موج (μm)	بهینه	ضریب بازتاب
.	.054	1	1
.	.068	1	1
.	.072	1	1
.	.096	1	1
.	1	1	1

جدول ۴: نوع و تعداد لایه ها در طول موج های مختلف برای ضریب جذب

ضریب بهینه جذب	طول موج(μm)	نوع لایه ها											
		۲	۳	۳	۲	۲	۲	۳	۳	۲	۰	۰	۰
۰/۶۸۹۵۵	۰/۵۴												
۰/۶۸۸۱	۰/۶۸	۲	۲	۳	۲	۲	۳	۲	۲	۰	۰	۰	۰
۰/۶۹۳۸۴	۰/۸۲	۳	۳	۳	۳	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۶۹۴۰۲	۰/۹۶	۲	۳	۲	۳	۲	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۸۹۹۰۶	۱	۳	۲	۳	۱	۲	۳	۲	۱	۱	۰	۰	۰

جدول ۷: ضخامت لایه ها در طول موج های مختلف برای ضریب بهینه بازتاب

جدول ۵: ضخامت لایه ها در طول موج های مختلف برای ضریب بهینه جذب

۱	۰/۹۶	۰/۸۲	۰/۶۸	۰/۵۴	طول موج(μm)	نوع لایه ها											
						۱	۰/۹۶	۰/۸۲	۰/۶۸	۰/۵۴	طول موج(μm)						
۰/۱۳۴۵۲	۵۰۰	۰/۲	۵۰۰	۰/۱۹۸۹۷		۰/۰۹۶۶۲۸۶						۰/۱۵۶۰۸					
۰/۱۴۶۳۹۸	۵۰۰	۰/۱۱۸۸	۰/۱۱۹۴۹			۰/۰۸۳۰۰۶۸	۰/۱۸۴۷۶	۰/۰۱۵۷۳۷	۰/۰۲۱۱۳۲	۰/۰۱۹۵۸۴							
۰/۱۸۹۹۴	۵۰۰	۰/۱۲۶۱۲	۰/۱۱۹۹	۵۰۰		۰/۰۱۸۵۱	۰/۰۹۳۷	۰/۰۱۳۹۵	۰/۰۱۲۰۲	۰/۰۱۵۵۷							
۰/۱۹۹۱۱	۰/۱۴۸۸۹	۵۰۰	۰/۰۳۷۶			۰/۰۱۹۰۲۹۸	۰/۰۲	۰/۰۱۸۳۶۸	۰/۰۱۶۱۸۷	۰/۰۱۸۲۸۹							
۰/۱۸۵۸	۰/۰۲۹۷	۰/۱۲۸۷				۰/۰۵۰۰	۰/۰۱۶۹۷										
۰/۳۵۶۴۵	۰/۵۴	۲	۱	۲	۳	۱	۱	۱	۳	۲	۰	۰					
۰/۳۲۹۵۲	۰/۶۸	۲	۱	۳	۱	۲	۳	۳	۱	۳	۰	۰					
۰/۳۱۷۸۱	۰/۸۲	۳	۲	۱	۳	۲	۳	۲	۳	۳	۰	۰					
۰/۳۱۱۵۴	۰/۹۶	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰/۳۹۴۴۲	۱	۲	۳	۱	۲	۳	۲	۳	۲	۳	۰	۰					

جدول ۶: نوع و تعداد لایه ها در طول موج های مختلف برای ضریب بازتاب

ضریب بهینه بازتاب	طول موج(μm)	نوع لایه ها											
		۲	۱	۲	۳	۱	۱	۱	۳	۲	۰	۰	۰
۰/۳۵۶۴۵	۰/۵۴												
۰/۳۲۹۵۲	۰/۶۸	۲	۱	۳	۱	۲	۳	۳	۱	۳	۰	۰	۰
۰/۳۱۷۸۱	۰/۸۲	۳	۲	۱	۳	۲	۳	۲	۳	۳	۰	۰	۰
۰/۳۱۱۵۴	۰/۹۶	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰/۳۹۴۴۲	۱	۲	۳	۱	۲	۳	۲	۳	۲	۳	۰	۰	۰

مراجع

- [9] M.Born,E.wolf,A.B.Bhatia.Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light, 7th ed., New York: Cambridge University,press,(1999)
- [10] K. Joulain,j.Mulet,F.Marquier,R.Carminati, Surface electromagnetic waves thermally excited: Radiative heat transfer, coherence properties and Casimir forces revisited in the near field, Surface Science Reports, Vol. 57, pp. 59-112,(2005)
- [11] H.Izakian,Bt.Ladani,A.Abraham,V.A.Snasel,discrete particle swarm optimization approach for grid job scheduling,Int J Innov Comp Inf Cont6(2010)
- [12] K.Wu tunable workflow scheduling algorithm based on particle swarm optimization for cloud computing(2014)
- [13] J.Kennedy,R.Eberhart, Particle swarm optimization,IEEE Int Conf Neu Net 4(1995)
- [14] J.Huang,K.Wu,L.Leong,S.Ma,M.Moh,A.tunable workflow scheduling algorithm based on particle swarm optimization for cloud computing. Int J Soft Comput Soft Eng (2013)
- [15] S.Prathibha,B.Latha,G.Suamthi,Particle swarm optimization based workflow scheduling for medical applications in cloud. Biomedical Research(2017)
- [16] D.F.W. Yap, S.P. Koh, S.K. Tiong and S.K. Prajindra, Particle Swarm based Artificial Immune System for Multimodal Function Optimization and Engineering Application Problem, Trends in Applied Sciences Research (2011)
- [17] D. C. Diana,S. P. Joy Vasantha Rani, Modified PSO-Based Equalizers for Channel Equalization, Proceedings of the International Conference on Nano-electronics, Circuits & Communication Systems ,(2017.)
- [1] C.Tien,H.Yang,M.Liu,Thin Solid Film, proceeding of 4th International Conference on Technological Advances of Thin Films and Surface Coatings, Illinois, USA(2009)
- [2] A. Wagendristel,Y. Wang,An Introduction of Physics and echnology of Thin Films ,In World Scientific,(1994)
- [3] K. N. Chopra, A. K. Maini,Thin Film and Their Applications in Military and Civil Sectors,Defence Research and Development Organisation,(2010)
- [4] ع. رازقی زاده, فیزیک لایه‌های نازک, دانشگاه پیام نور, تهران, (۱۳۸۸)
- [5] ز.فخاران, ل.ناجی, خ.معدنی پور, بررسی تاثیر شرایط اکسایش، ضخامت و دما بر هدایت الکتریکی لایه نازک های شفاف بر پایه اکسید گرافن کاوش یافته، نخبگان علوم و مهندسی(۱۳۹۵)
- [6] h.choday,k.w.kwon,k.roy,Workload dependent evaluation of thin-film thermoelectric devices for on-chip cooling and energy harvesting, Proceedings of ICCAD-14, San Jose, California, USA, (2014)
- [7] E.Silik,S.Pat,S.Özen,R.Mohammadigharehbagh,H.Hakan Yudar,C.Musaoğlu,Ş.Korkmaz, Electrochromic properties of TiO₂ thin films grown by thermionic vacuum arc method,Thin Solid Films, 640(2017)
- [8] Y.Yang,T.Wang,C.Liu,W.Li,J.Zhang,L.Wu,G.Zeng,W. Wang,M.Yu, Single phase control of CuTe thin films for CdTe solar cells, Vacuum,142(2017)